
	<h2 style="color: red;">FQD7N20LTM</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD7N20LTM</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 5.5A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD7N20LTM.pdf 2.FQD7N20LTM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 3970 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD7N20LTM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 5.5A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	3970 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 5.5A (Tc) 2.5W (Ta), 45W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 45W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	750 mOhm @ 2.75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	500pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQD7N20LTMCT

FQD7N20LTM ist neu im Original. Suche FQD7N20LTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD7N20LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD7N20LTM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD7N20TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p>	 <p>FQD7N20TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p>	 <p>FQD7N20LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.5A DPAK</p>	 <p>FQD7N20TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p>
 <p>FQD7N20TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p>	 <p>FQD7N20LTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.5A DPAK</p>	 <p>FQD7N20L F FQD7N20L F</p>	 <p>FQD7N10TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 5.8A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD6N40C	↔ FQD6N40CTM	⇒ FQD6N40CTM	D FQD6N50CTF	↕ FQD6N50CTF
⊣ FQD6N50CTM	⊗ FQD6N50CTM	D FQD6N60C	⇒ FQD6N60CS	↕ FQD6N60CTF
⊗ FQD6N60CTM	⊣ FQD6N60CTM	⊗ FQD6P25TM	↔ FQD6P25TM	↕ FQD7N10L
D FQD7N10LTF	⊗ FQD7N10LTF	⊣ FQD7N10LTM	⊗ FQD7N10LTM	↕ FQD7N10TF
⇒ FQD7N10TM	↔ FQD7N10TM	⊗ FQD7N20L	⊣ FQD7N20LTF	↕ FQD7N20LTF
↔ FQD7N20LTM	⇒ FQD7N20TF	D FQD7N20TF	⊗ FQD7N20TM	⊣ FQD7N20TM
⊗ FQD7N30TM	D FQD7N30TM	⇒ FQD7P06TF	↔ FQD7P06TF	↕ FQD7P06TM
⊣ FQD7P06TM	⊗ FQD7P06TM_F080	↔ FQD7P06TM_F080	⇒ FQD7P06TM_NB82050	↕ FQD7P06TM_NB82050
⊗ FQD7P10TF	⊣ FQD7P20TF	⊗ FQD7P20TF	D FQD7P20TM	↕ FQD7P20TM
↔ FQD7P20TM_F080	⊗ FQD7P20TM_F080	⊣ FQD8P10TF	⊗ FQD8P10TF	↕ FQD8P10TF_NB82052

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

